

Технические характеристики биполярного транзистора КТ357Г

•

Транзистор	V_{1-2}/I_k /мА	f_T МГц	C_k/U_k пф/В	$C_э/U_э$ пф/В	$R_b^*C_k$ псек	t_p нс	$U_{кэ}/(I_k/I_b)$ В/(мА/мА)	$I_{к0}$ мкА	$U_{кб}$ В	$U_{кэ}/R$ В/кОм	$U_{эб}$ В	$I_{км}/I_{кн}$ мА/мА	P_k мВт	Пер
КТ357Г	60-300/10	300	7/5	10/0		250	0.3(10/1)	5	20	20/	3.5	40/	100	P-N-P

- **Область применения:** для переключения и усиления сигналов высокой частоты

Условные обозначения электрических параметров биполярного транзистора КТ357Г

Обозначение:	Параметр
V_{1-2}/I_k /мА	статический коэффициент передачи тока
f_T МГц	предельная частота коэффициента передачи тока
C_k/U_k пф/В	емкость коллекторного перехода (C_k) и напряжение на коллекторе (U_k), при котором она измеряется
$C_э/U_э$ пф/В	емкость эмиттерного перехода ($C_э$) и напряжение эмиттер/база ($U_э$), при котором она измеряется
$R_b^*C_k$ псек	постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте
t_p нс	
$U_{кэ}/(I_k/I_b)$ В/(мА/мА)	напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($U_{кэ}$) биполярного транзистора при заданном токе коллектора (I_k) и заданном токе базы (I_b)
$I_{к0}$ мкА	обратный ток коллектора
$U_{кб}$ В	максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база
$U_{кэ}/R$ В/кОм	максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер ($U_{кэ}$) при заданной величине сопротивления, включенного между базой и эмиттером (R)
$U_{эб}$ В	максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база
$I_{км}/I_{кн}$ мА/мА	предельно допустимый постоянный ($I_{км}$) ток коллектора предельно допустимый ток коллектора в режиме насыщения ($I_{кн}$)или в импульсе
P_k мВт	максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на коллекторе
Пер	

* Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.

Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима.

Параметр, помеченный буквой "т" означают, что приводится типовое значение.